N		Datenblatt / Data sheet	Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG
Netz-Thyristor Phase Control Thyristor		**T1080N**	

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	T_{vj} = -40°C... $T_{vj\,max}$	V_{DRM},V_{RRM}	200 400 600	V V V
Vorwärts-Stossspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	T_{vj} = -40°C... $T_{vj\,max}$	V_{DSM}	200 400 600	V V V
Rückwärts-Stossspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = +25°C... $T_{vj\,max}$	V_{RSM}	250 450 650	V V V
Durchlassstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		I_{TRMSM}	2000	A
Dauergrenzstrom average on-state current	T_C = 85 °C	I_{TAVM}	1078	A
Dauergrenzstrom average on-state current Durchlaßstrom-Effektivwert RMS on-state current	T_C = 55 °C, θ = 180°sin, t_P = 10 ms	I_{TAVM} I_{TRMS}	1470 2320	A A
Stossstrom-Grenzwert surge current	T_{vj} = 25 °C, t_P = 10 ms T_{vj} = $T_{vj\,max}$, t_P = 10 ms	I_{TSM}	16000 14500	A A
Grenzlastintegral I^2t-value	T_{vj} = 25 °C, t_P = 10 ms T_{vj} = $T_{vj\,max}$, t_P = 10 ms	I^2t	1280 1050	10^3 A^2s 10^3 A^2s
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 60747-6 f = 50 Hz, i_{GM} = 0,8 A, di_G/dt = 0,8 A/µs	$(di_T/dt)_{cr}$	200	A/µs
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	T_{vj} = $T_{vj\,max}$, v_D = 0,67 V_{DRM} 5.Kennbuchstabe / 5th letter F	$(dv_D/dt)_{cr}$	1000	V/µs

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlassspannung on-state voltage	T_{vj} = $T_{vj\,max}$, i_T = 3,5 kA T_{vj} = $T_{vj\,max}$, i_T = 1 kA	v_T	max. 1,81 max. 1,26	V V
Schleusenspannung threshold voltage	T_{vj} = $T_{vj\,max}$	$V_{(TO)}$	1,02	V
Ersatzwiderstand slope resistance	T_{vj} = $T_{vj\,max}$	r_T	0,2	mΩ
Durchlasskennlinie 300 A ≤ i_T ≤ 5400 A on-state characteristic $v_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$	T_{vj} = $T_{vj\,max}$	A= B= C= D=	7,666E-01 2,129E-04 4,756E-02 -1,521E-03	
Zündstrom gate trigger current	T_{vj} = 25 °C, v_D = 12V	I_{GT}	max. 200	mA
Zündspannung gate trigger voltage	T_{vj} = 25 °C, v_D = 12V	V_{GT}	max. 2	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	T_{vj} = $T_{vj\,max}$, v_D = 12V T_{vj} = $T_{vj\,max}$, v_D = 0,5 V_{DRM}	I_{GD}	max. 10 max. 5	mA mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	T_{vj} = $T_{vj\,max}$, v_D = 0,5 V_{DRM}	V_{GD}	max. 0,25	V
Haltestrom holding current	T_{vj} = 25°C, v_D = 12V	I_H	max. 200	mA
Einraststrom latching current	T_{vj} = 25°C, v_D = 12V, R_{GK} ≥ 10 Ω i_{GM} = 0,8 A, di_G/dt = 0,8 A/µs, t_g = 20 µs	I_L	max. 1000	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current	T_{vj} = $T_{vj\,max}$ v_D = V_{DRM}, v_R = V_{RRM}	i_D, i_R	max. 80	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 60747-6 T_{vj} = 25 °C, i_{GM} = 0,8 A, di_G/dt = 0,8 A/µs	t_{gd}	max. 1,4	µs

prepared by:	H.Sandmann		date of publication:	2010-01-18
approved by:	M.Leifeld		revision:	3.1

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Charakteristische Werte / Characteristic values

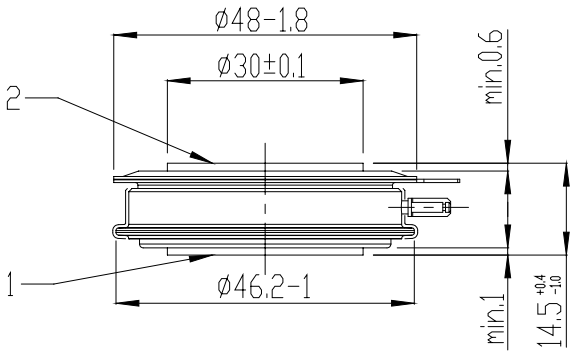
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\,max}$, $i_{TM} = I_{TAVM}$ v_{RM} = 100 V, v_{DM} = 0,67 V_{DRM} dv_D/dt = 20 V/µs, $-di_T/dt$ = 10 A/µs 4.Kennbuchstabe / 4th letter O	t_q	typ.	150	µs

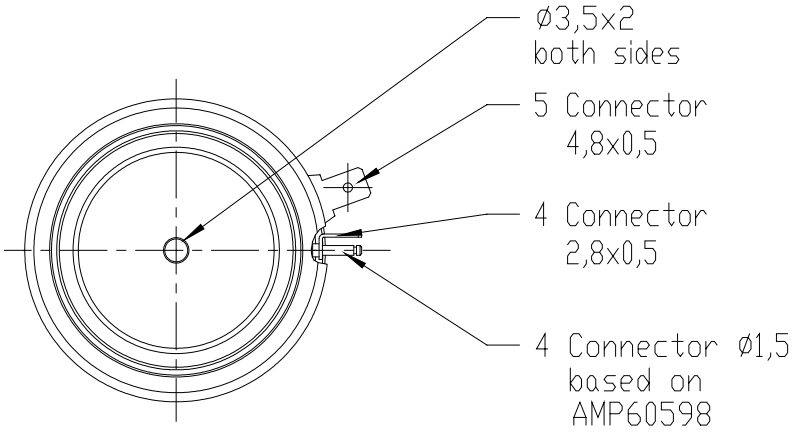
Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided, θ = 180°sin beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, θ = 180°sin Anode / anode, DC Kathode / cathode, θ = 180°sin Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	 max. max. max. max. max. max.	 0,033 0,030 0,059 0,056 0,068 0,065	 °C/W °C/W °C/W °C/W °C/W °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sides einseitig / single-sides	R_{thCH}	 max. max.	 0,006 0,012	 °C/W °C/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\,max}$		140	°C
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\,op}$		-40...+140	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}		-40...+150	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

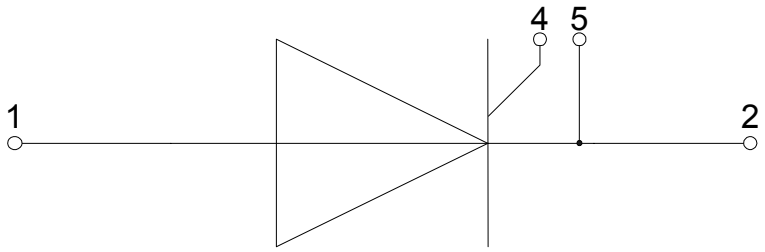
Gehäuse, siehe Anlage case, see annex				Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact					
Anpresskraft clamping force		F		8...16	kN
Steueranschlüsse control terminals	Gate (flat) Gate (round, based on AMP 60598) Kathode / cathode			A 2,8x0,5 Ø 1,5 A 4,8x0,5	mm mm mm
Gewicht weight		G	typ.	110	g
Kriechstrecke creepage distance				6	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50 Hz			50	m/s²





strike distance: 5,0mm
creepage distance: 6,0mm

overall height based
on contact pressure



1: Anode / Anode

2: Kathode / Cathode

4: Gate

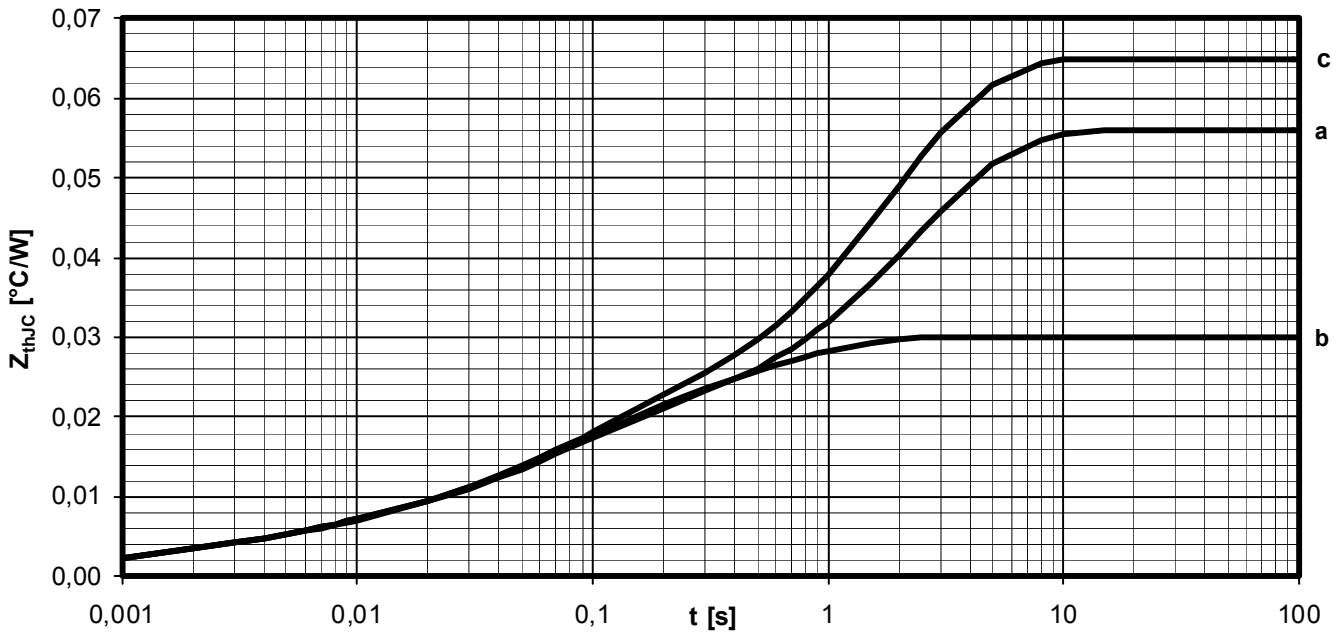
5: Hilfskathode/
Auxiliary Cathode

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

Kühlung / Cooling	Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	R_{thn} [°C/W]	0,00160	0,0026	0,0024	0,0123	0,0111	-	-
	τ_n [s]	0,00064	0,0034	0,0127	0,0722	0,5230	-	-
anodenseitig anode-sided	R_{thn} [°C/W]	0,00160	0,0026	0,0024	0,0123	0,0371	-	-
	τ_n [s]	0,00064	0,0034	0,0127	0,0722	2,3000	-	-
kathodenseitig cathode-sided	R_{thn} [°C/W]	0,00160	0,0026	0,0024	0,0123	0,0461	-	-
	τ_n [s]	0,00064	0,0034	0,0127	0,0722	1,8700	-	-

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{\frac{-t}{\tau_n}}\right)$$



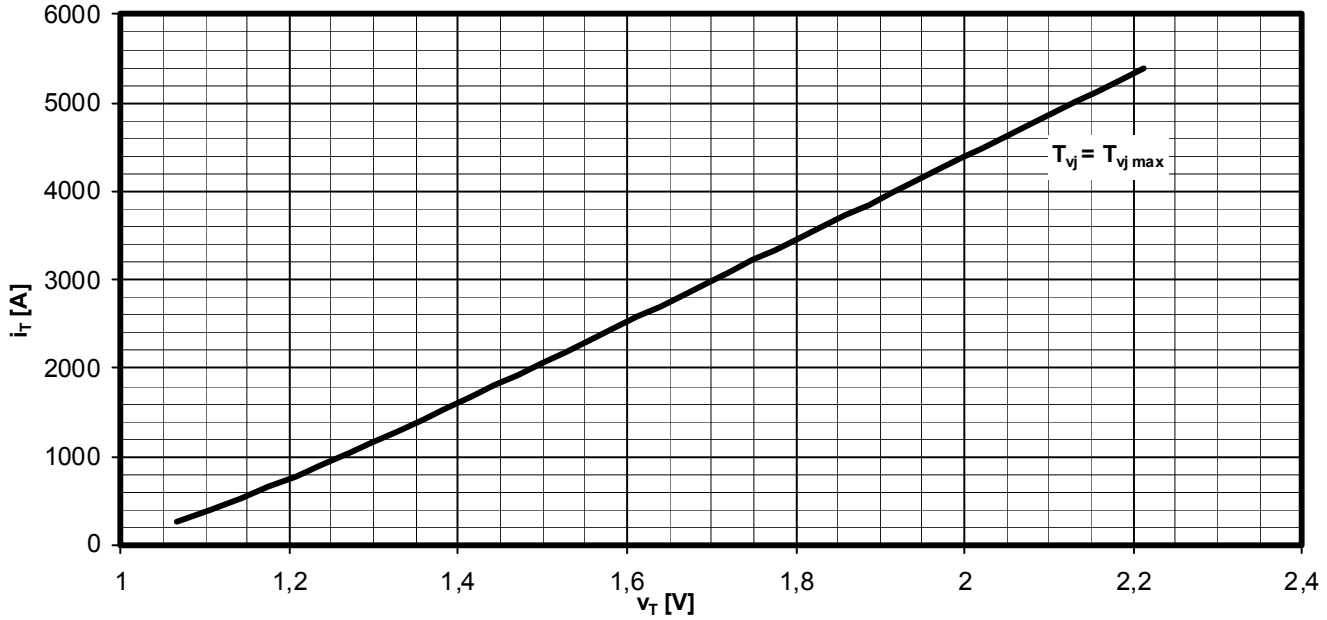
Transienter innerer Wärmewiderstand für DC / Transient thermal impedance for DC
$Z_{thJC} = f(t)$

a - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
b - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
c - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling

Erhöhung des $Z_{th\,DC}$ bei Sinus und Rechteckströmen mit unterschiedlichen Stromflusswinkeln Θ
Rise of $Z_{th\,DC}$ for sinewave and rectangular current with different current conduction angles Θ
$\Delta Z_{th\,\Theta\,rec}$ / $\Delta Z_{th\,\Theta\,sin}$

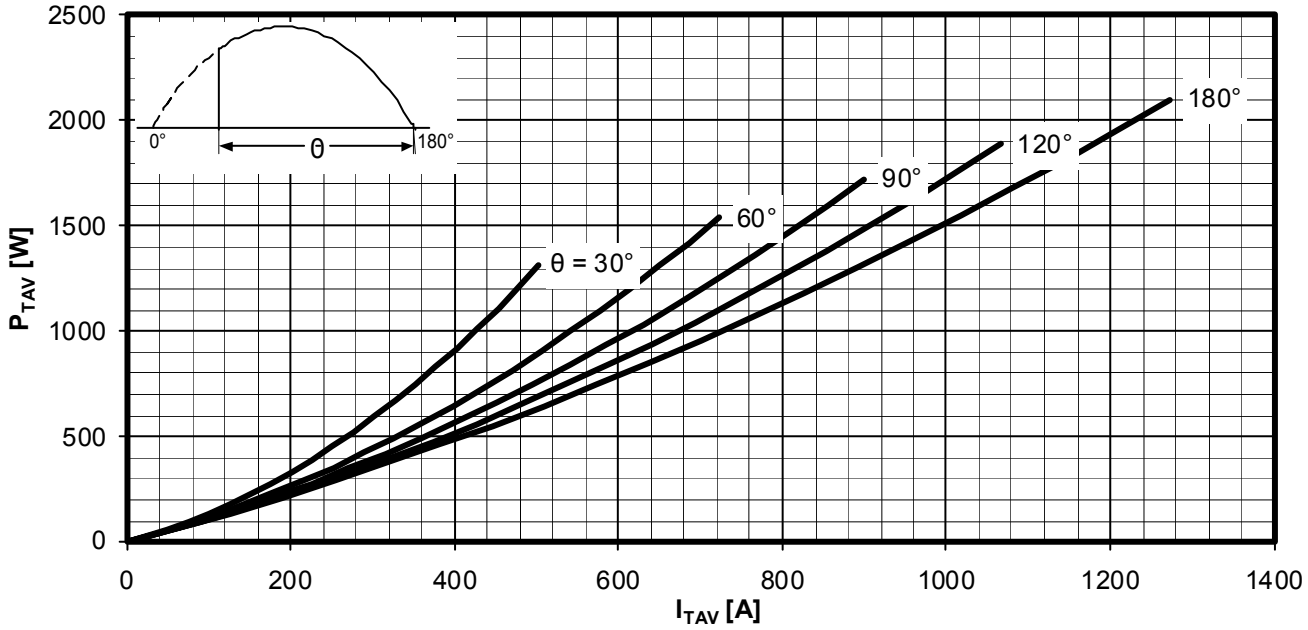
Kühlung / Cooling		Θ = 180°	Θ = 120°	Θ = 90°	Θ = 60°	Θ = 30°
beidseitig two-sided	$\Delta Z_{th\,\Theta\,rec}$ [°C/W]	0,00579	0,00992	0,01324	0,01857	0,02959
	$\Delta Z_{th\,\Theta\,sin}$ [°C/W]	0,00289	0,00453	0,00680	0,01093	0,02142
anodenseitig anode-sided	$\Delta Z_{th\,\Theta\,rec}$ [°C/W]	0,00577	0,00989	0,01320	0,01853	0,02955
	$\Delta Z_{th\,\Theta\,sin}$ [°C/W]	0,00286	0,00450	0,00676	0,01088	0,02138
kathodenseitig cathode-sided	$\Delta Z_{th\,\Theta\,rec}$ [°C/W]	0,00581	0,00994	0,01326	0,01860	0,02963
	$\Delta Z_{th\,\Theta\,sin}$ [°C/W]	0,00291	0,00454	0,00682	0,01095	0,02146

$$Z_{th\,\Theta\,rec} = Z_{th\,DC} + \Delta Z_{th\,\Theta\,rec}$$
$$Z_{th\,\Theta\,sin} = Z_{th\,DC} + \Delta Z_{th\,\Theta\,sin}$$



Grenzdurchlasskennlinie / Limiting on-state characteristic $i_T = f(v_T)$

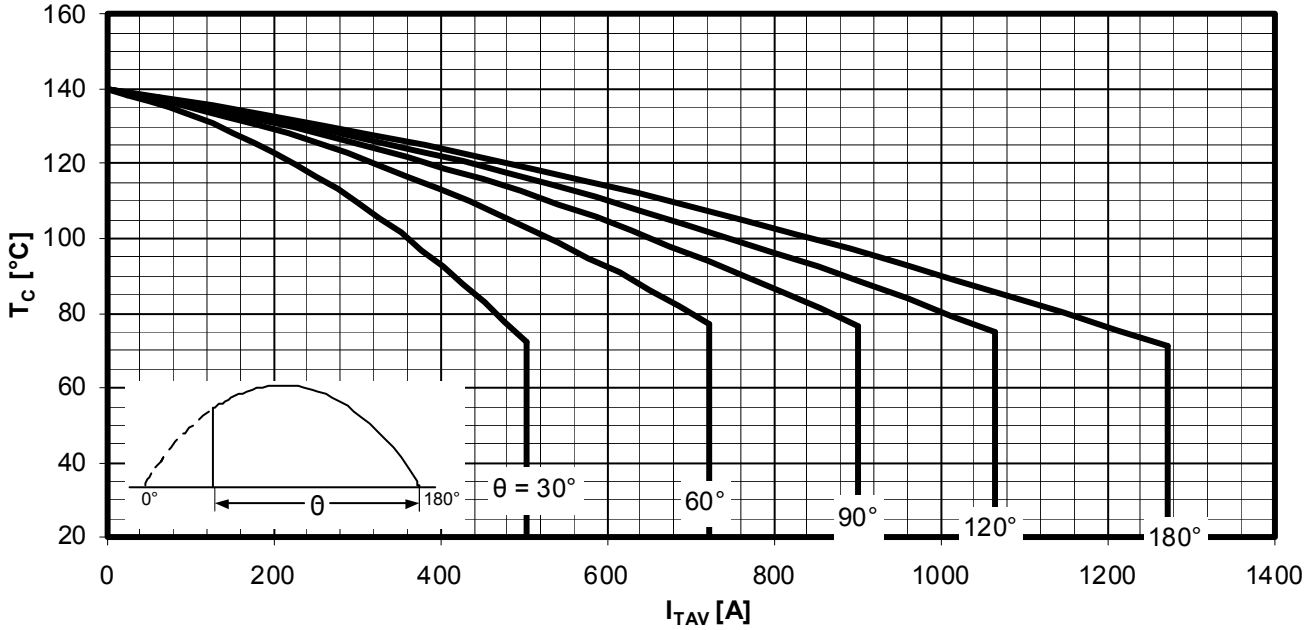
$T_{vj} = T_{vj\,max}$



Durchlassverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current

Parameter: Stromflusswinkel Θ / Current conduction angle Θ

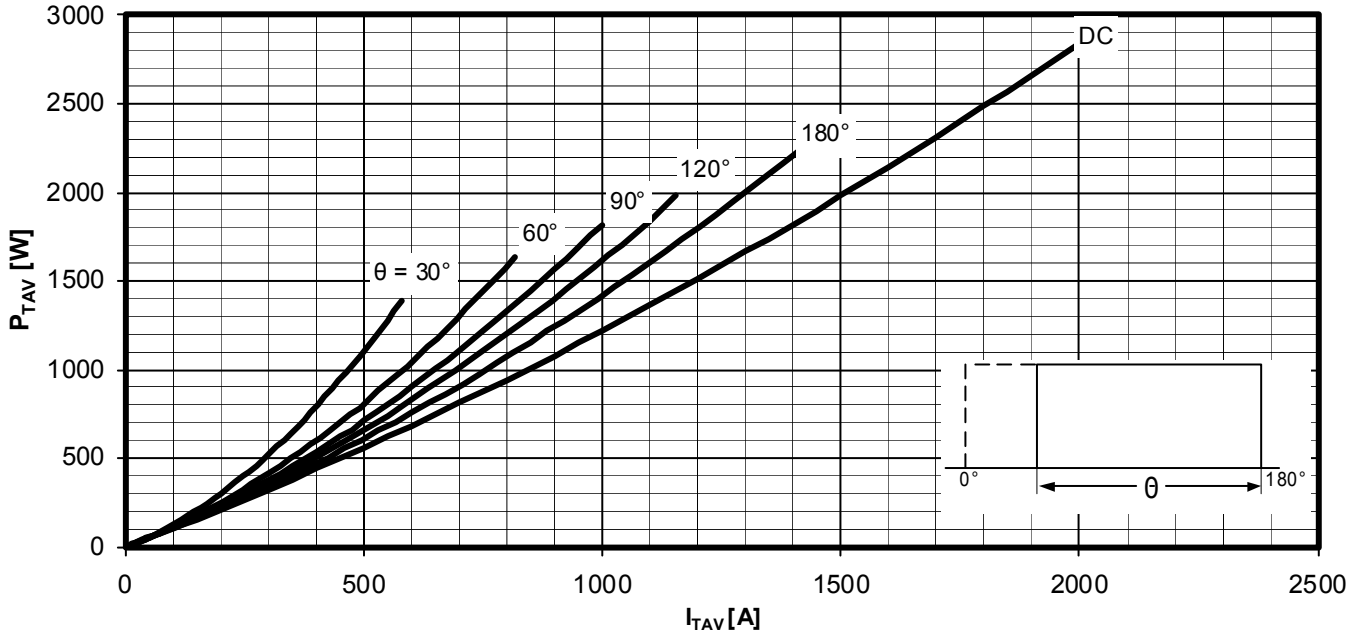


Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_C = f(I_{TAV})$

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

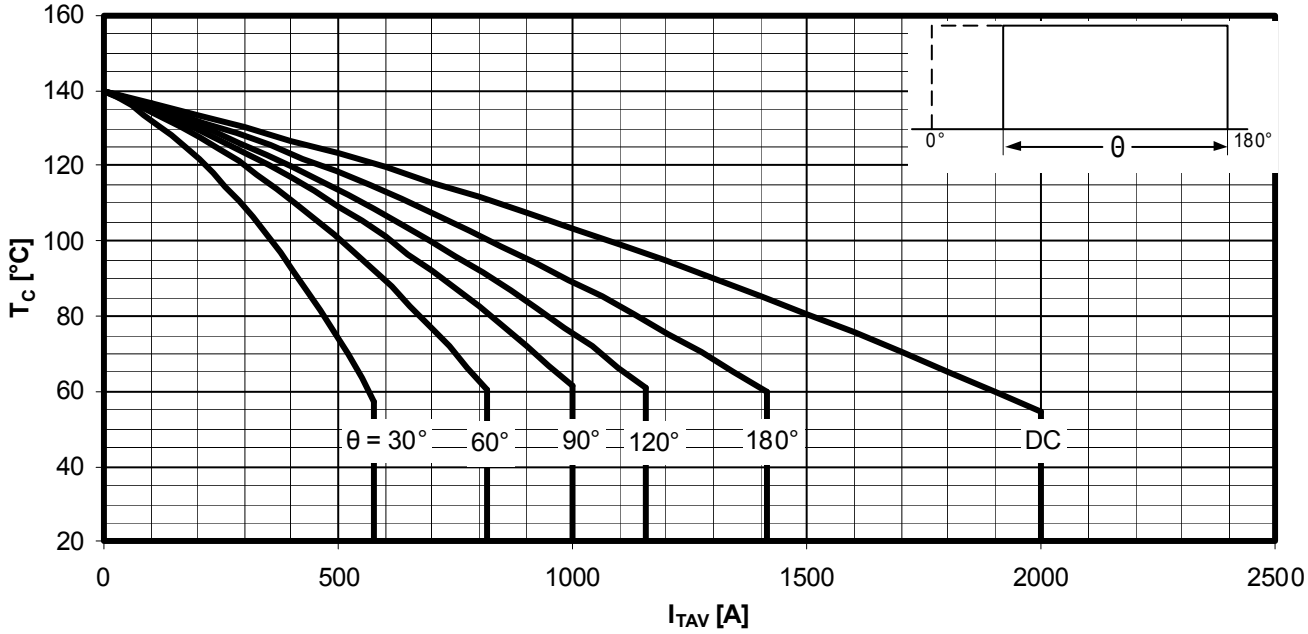
Parameter: Stromflusswinkel Θ / Current conduction angle Θ



Durchlassverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$

Rechteckförmiger Strom / Rectangular current

Parameter: Stromflusswinkel Θ / Current conduction angle Θ

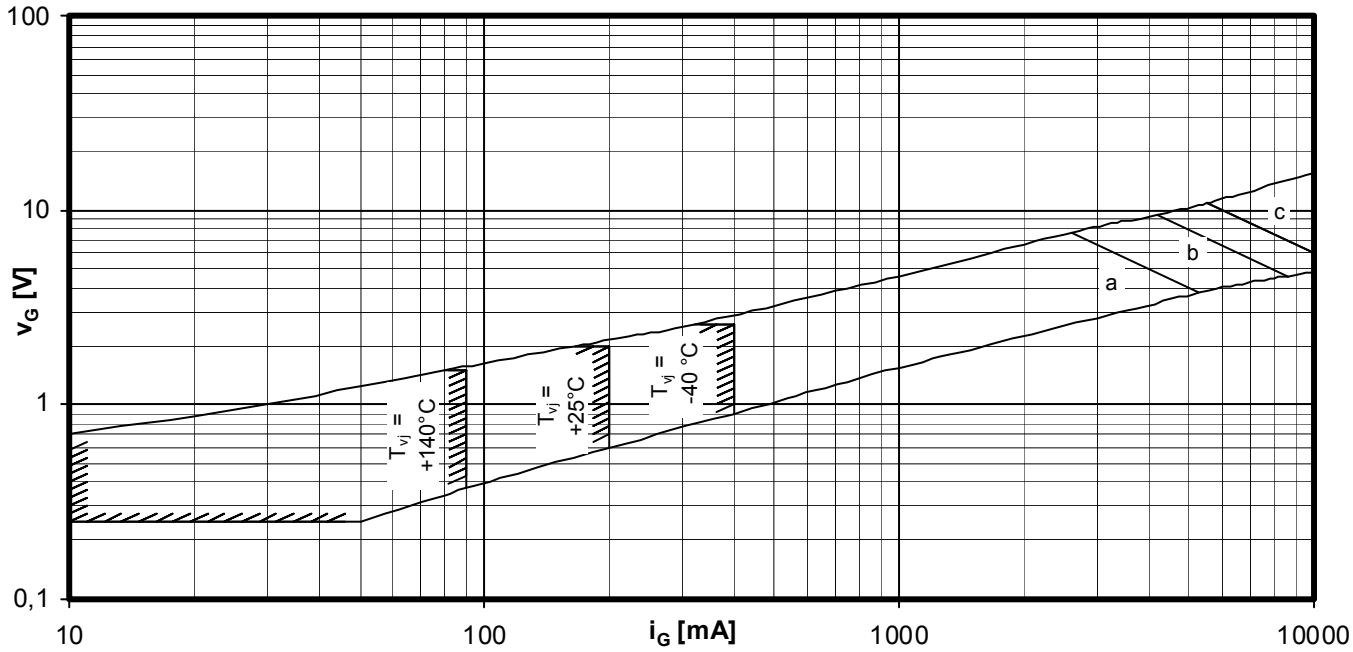


Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_C = f(I_{TAV})$

Rechteckförmiger Strom / Rectangular current

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

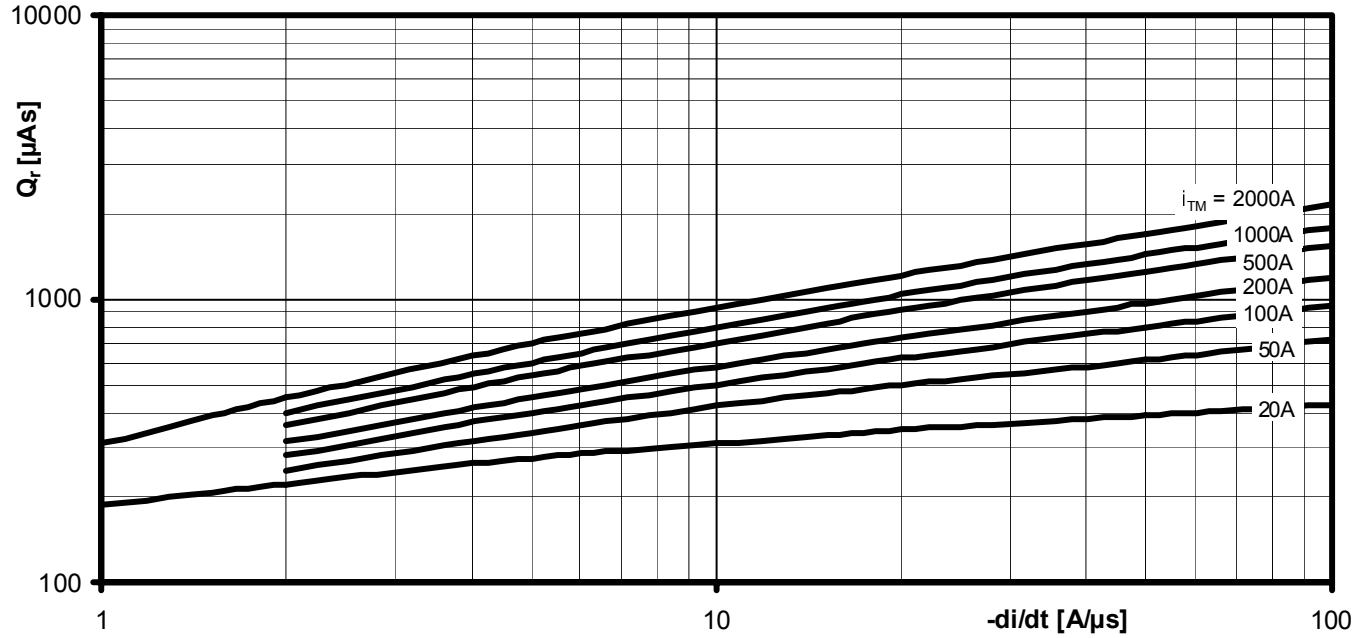
Parameter: Stromflusswinkel Θ / Current conduction angle Θ



Steuercharakteristik $v_G = f(i_G)$ mit Zündbereichen für $V_D = 12$ V
Gate characteristic $v_G = f(i_G)$ with triggering area for $V_D = 12$ V

Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation $P_{GM} = f(t_g)$:

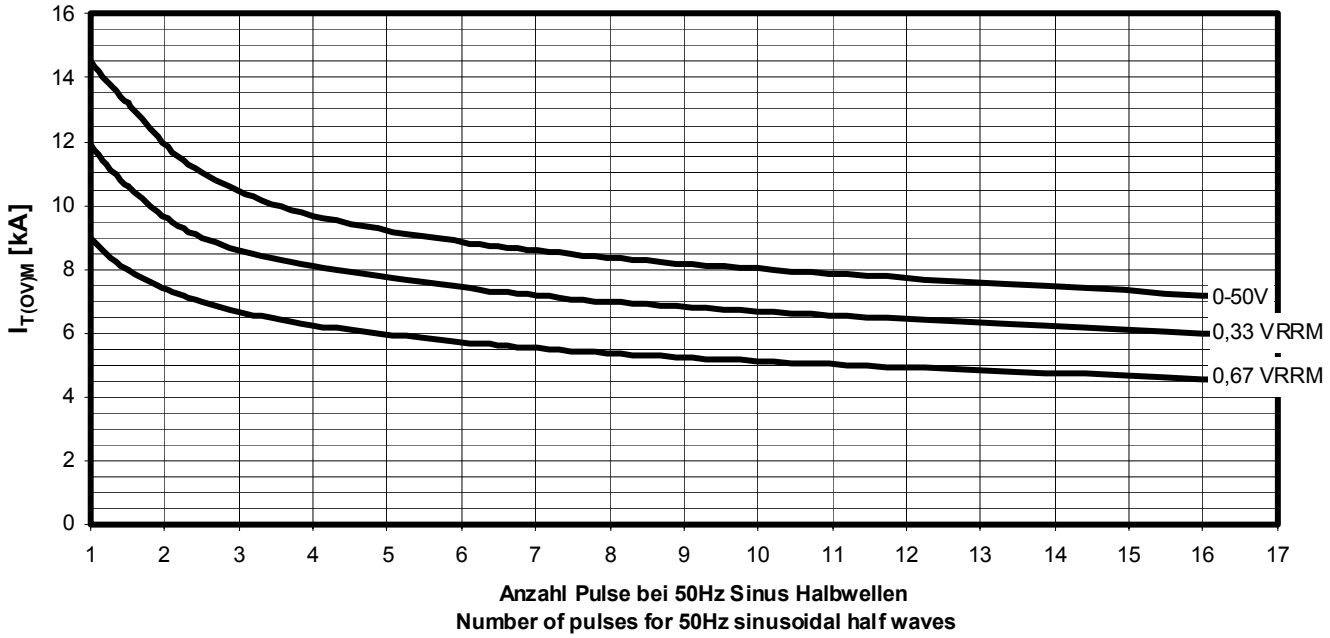
a - 20W / 10ms b - 40W / 1ms c - 60W / 0,5ms



Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(di/dt)$

$T_{vj} = T_{vjmax}$, $v_R \leq 0{,}5\ V_{RRM}$, $V_{RM} = 0{,}8\ V_{RRM}$

Parameter: Durchlassstrom / On-state current i_{TM}



Typische Abhängigkeit des Grenzstromes $I_{T(OV)M}$ von der Anzahl für eine Folge von Sinus Halbwellen bei 50Hz. Parameter: Rückwärtsspannung V_{RM}
Typical dependency of maximum overload on-state current $I_{T(OV)M}$ as a number of a sequence of sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage V_{RM}
$I_{T(OV)M}$ = f (pulses, V_{RM}) ; $T_{vj} = T_{vjmax}$

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.
Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331